

МАШИНОЗНАВСТВО. ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

УДК 538.975:621.793

І.Г. Грабар, д.т.н., проф.

В.А. Рудницький, к.ф.-м.н., доц.

Житомирський державний технологічний університет

МОДЕлювання і ТЕХНОЛОГІЯ об'ємного НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ У ВАКУУМІ

В роботі наводяться дані експериментального дослідження і моделювання умов об'ємного нанесення покріттів з метою удосконалення вакуумних технологій. Проведено аналіз досліджень і зроблено висновки про фактори, що найбільш впливають при формуванні плівки на об'ємних підкладках. Установлено оптимальні значення тиску напуску газів при проведенні напилення і доведена перевага плазмових випарників при об'ємному нанесенні покріттів у вакуумі перед термічними.

Постановка проблеми та аналіз досліджень і публікацій.

Вироби із суцільних одпорідних матеріалів вичерпали можливість удосконалення, на їх зміну приходять плівки, які дають можливість використання їхніх цінних властивостей на дешевій основі. Існують різноманітні способи отримання плівок, серед них – вакуумно-плазмові. Ці методи цінні, перш за все, можливістю зчеплення матеріалу, який конденсується, безпосередньо з поверхнею при віддаленні шару адгезованих газів з поверхні підкладки, а також можливістю керування енергією частинок, які створюють плівку. Ця снергія впливає на адгезію та інші властивості плівки.

Практичне застосування вакуумно-плазмових методів обмежене у великий мірі через недостатність даних з теорії та практики об'ємного напилення. Мається на увазі, що у випадку наявності деталей складної форми зпайдуться поверхні, з яких довгий час не видно джерела пари, нормаль до яких складає великий кут з напрямком на джерело пари речовини, яка напилюється або є компонентом синтезу плівки. Ці поверхні і потребують бомбардування потоками, які конденсуються, під різними кутами одночасно, а при обертанні деталей той чи інший напрямок конденсації буде відігравати основну роль в конкретний момент часу.

Об'ємне нанесення (напилення) покріттів – спосіб ізотропного формування плівки на об'ємних підкладках (виробах) складної форми. В практиці вакуумного осадження плівок і покріттів доводиться мати справу із великою кількістю виробів, які встановлені на одній основі (підкладці). При цьому одні вироби можуть перекривати напрям на випарник для інших у невідповідних положеннях підкладки. Тому практичну цінність будуть мати дослідження, які розширяють потік пари робочої речовини, щоб в його зону попадали поверхні виробів, які в деяких положеннях підкладки по відношенню до випарника перекріті. Крім розширення потоку важливим для об'ємного нанесення покріттів є дослідження частинок, які рухаються не по прямій лінії і можуть осаджуватись на перекритих поверхнях виробів. Наведені факти складають у цілому ефект об'ємного напилення, який виявляється навіть у випадку осадження від одного випаровувача робочої речовини. На практиці, звичайно, для підвищення цього ефекту використовують декілька випаровувачів, потоки пари робочої речовини від яких перетинаються в районі підкладки.

Об'ємне напилення не досліджувалось з метою створення цілісної теорії. Поради стосовно розміщення випаровувачів у вакуумній камері можна знайти в літературі практичного змісту [1]. Існують розрізнені дані в наукових роботах за ступенем розсіяння плазмових пучків і потоків [2], [3].

Формулювання цілей статті.

Наши концепція передбачає для такого напилення наявність декількох випарників, які дають взаємно перпендикулярні напрямки потоків пари, а також підвищений надлишковий тиск у вакуумній камері для ефективного зіткнення молекул і зміни напрямку бомбардування ними підкладки. В задачу наших досліджень входило знайти величини, які могли б ефективно

характеризувати режим роботи випарника і його потік плазми з метою використання для об'ємного напилення, вивчення діаграми направленості (просторового радіального розподілу інтенсивності) потоку плазми випарника та її залежність від режиму подачі газу, місця розміщення і режиму роботи випарника з метою визначення можливостей цілеспрямованого керування. Наші дослідження не обмежувались теоретичними, а висновки з них лягли в основу створення більш досконаліх випарників.

Основний матеріал дослідження.

Випарник металів, який отримує енергію для випаровування із електричного розряду (плазмовий випарник), має специфіку в поширенні парів у вакуумній камері. Вона проявляється у більш широкій діаграмі направленості потоку, ніж у термічних випарниках (тигель гріється резистивним або індукційним струмом). Діаграма направленості (радіальний розподіл інтенсивності) потоку – це графічна залежність відносної інтенсивності переміщення речовини (відносної швидкості конденсації плавки на одиницю площини підкладки) від кута, який відкладається між віссю симетрії випарника і нормальню підкладки, продовження якої попадало на середину площини поверхні випаровування. На рис. 1, а зображене поширення парів титану від тигля із нітриду бору, який підігрівався до температури 1800 °C, а на рис. 1, б – діаграма направленості потоку парів від такого ж тигля, який розігрівався до температури 1800 °C електричним розрядом у парах титану (катод був плазмовий, падіння потенціалу між заземленою камерою і анодом 90 В, струм розряду 10 А, запалювання розряду здійснювалось попереднім нагріванням тигля електронним струмом). Температура була вибрана такою, що відповідала ефективному запалюванню розряду в парах речовини тигля і контролювалась прометричними методами. Для обох випадків тиск у вакуумній камері – $1 \cdot 10^{-4}$ мм рт. ст. Початок координат на діаграмі направленості – це точка, яка відповідає центру поверхні випаровування, яка найчастіше була кругом. Крім того, початок координат –

це центр концентричних кіл, радіуси яких рівні відносній інтенсивності потоку $k_\theta = \frac{I_\theta}{I_0}$,

де I_θ – інтенсивність у напрямку осі симетрії випарника ($\theta = 0^\circ$). Відносна інтенсивність потоку відкладається вздовж радіуса, напрямок якого визначається кутом відносно нормалі до поверхні випаровування, яка проведена через її центр. Напрямок підписується значенням кута в радіанній мірі.

Додаткові дослідження проводились за інтенсивністю потоку на підкладку, розміщену по осі симетрії випарника ($\theta = 0^\circ$), але при повернутій від цього напрямку нормалі на кут ϕ . Якщо розглядати потік частинок, які мають тільки складову швидкості вздовж напрямку осі симетрії випарника, то інтенсивність I_ϕ потоку для підкладки під кутом ϕ повинна косинусоїдально залежати від інтенсивності I_0 , яка визначена у випадку співпадання осі симетрії випарника і нормалі до підкладки ($\phi = 0^\circ$).

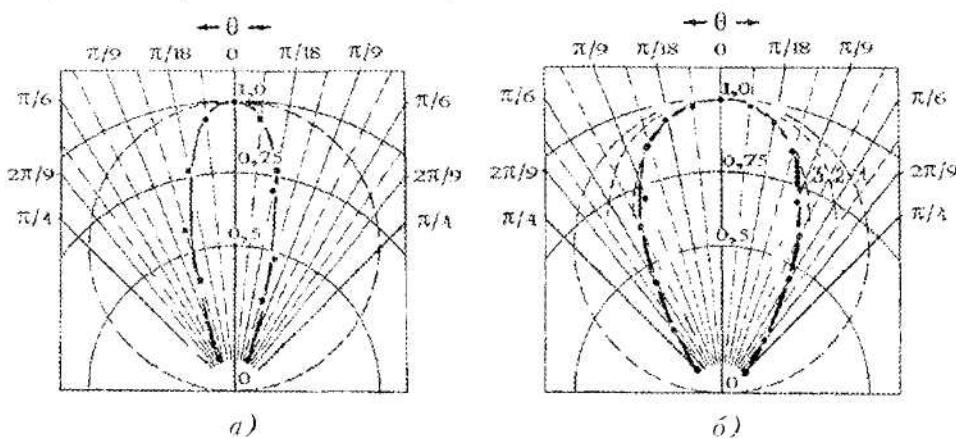


Рис. 1. Діаграма направленості потоку речовини, яка випаровується з тигля, що нагрівається:
а) від додаткового нагрівника $\mu = 0,52$; б) від електричного розряду $\mu = 0,6$

Оскільки $\frac{I_\varphi}{I_0} = \cos \varphi$, то $\frac{I_{60^\circ}}{I_0} = 0,5$. Але зіткнення між частинками, які призводять до розширення діаграми напряленості, збільшують також відношення $\mu = \frac{I_{60^\circ}}{I_0}$ (бокове запилення).

Радіальні розподіли потоку пари у двох випадках показують, що електричний розряд стимулює зіткнення частинок у потоці пари. З цієї причини діаграма напряленості для розряду піниша і μ більше.

Збільшення тиску призводить до збільшення зіткнень у зоні електричного розряду, що, у свою чергу, викликає збільшення кількості іонізованих частинок.

У випадку, коли електродом служить вакуумна камера, силові лінії електричного поля майже перпендикулярні до осі потоку пари. Заряджені частинки, рухаючись вздовж силових ліній електричного поля, стимулюють збільшення кількості зіткнень і розсіяння всього потоку. Щі висновки підтверджуються дослідженнями радіального розподілу інтенсивності потоку пари.

Для випадку, зображеного на рис. 1, а, відносна інтенсивність потоку k_θ для $\theta = \pi/4$ менша 0,01. Якщо тиск у вакуумній камері підняти до 10^{-3} мм рт. ст., то $k_{\pi/4}$ зросло до 0,05. Проте значно ефективніше для об'ємного паливання використати плазмове випарування. На рис. 2, а наведена діаграма напряленості потоку пари за тих же умов, що і для рис. 1, б, але при підвищенному тиску ($p = 10^{-3}$ мм рт. ст.). Для цього випадку $k_{\pi/4} \approx 0,2$.

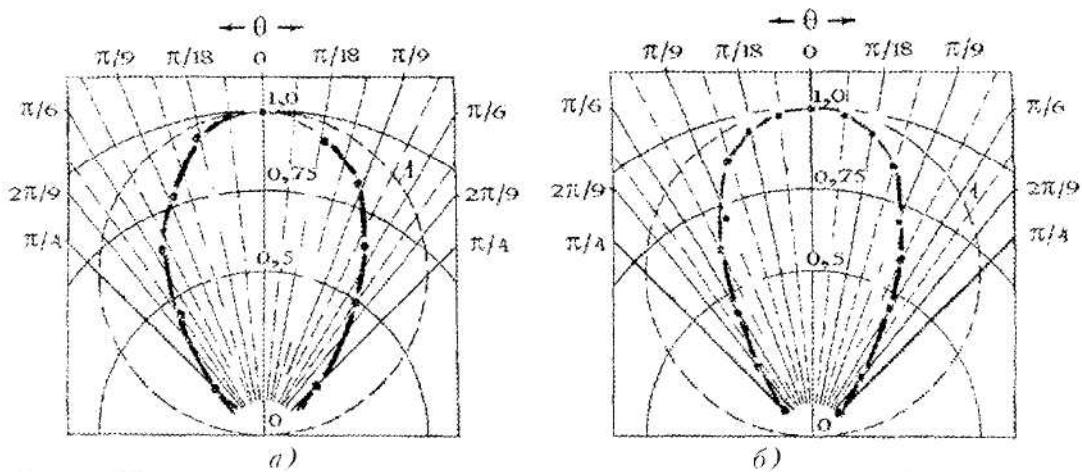


Рис. 2. Діаграма напряленості потоку пари матеріалу анода при різних тисках:
а) $p = 10^{-3}$ мм рт. ст., $\mu = 0,71$; б) $p = 5 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст., $\mu = 0,55$

Підвищення тиску газу у вакуумній камері може привести до ситуації, при якій відстань від випарника до підкладки в багато разів перевищує довжину вільного пробіту. В цьому випадку розширення діаграми напряленості інтенсивності потоку пари в районі підкладки буде не суттєвим у порівнянні з тим, що значно зменшиться чисельне значення інтенсивності потоку пари. На рис. 2, б зображене діаграму напряленості плазмового випарника за одинакових всіх інших умов з випадком, який зображене на рис. 2, а, крім тиску азоту. Тиск азоту був підвищений до $5 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст., а інтенсивність потоку пари на підкладку в напрямку осі випарника зменшилась у 10 разів.

Розсіяння речовини на шляху до підкладки, навіть при розширеній діаграмі напряленості потоку пари на підкладці, є невигідним для практики осадження і синтезу тонких плівок у вакуумній камері.

На рис. 3 зображені діаграми напряленості для випарника на основі вакуумно-дугового розряду. Дослідження інтенсивності потоку пари проводилось за таких умов: струм розряду для титанового катода, який охолоджується проточною водою, 100 А, робоча поверхня катода мала площину 34 см^2 і була віддалена від підкладки на 25 см. Тиск азоту у вакуумній камері складає:

$$p = 1 \cdot 10^{-4} \text{ мм рт. ст. (рис. 3, а); } p = 1 \cdot 10^{-3} \text{ мм рт. ст. (рис. 3, б).}$$

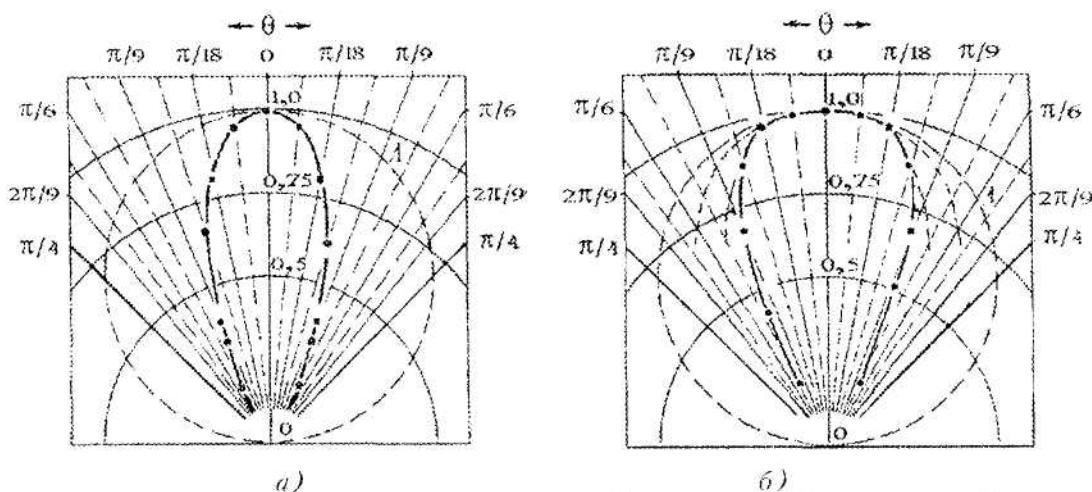


Рис. 3. Діаграма направленості потоку для вакуумно-дугового розряду:
а) $\mu = 0,57$; б) $\mu = 0,66$

Збільшення тиску у вакуумній камері, шляхом напуску газу (інертного або реакційного), спочатку призводить до зменшення довжини вільного пробігу, яка стає одного порядку із проміжком між випарником і підкладкою. За цих умов спостерігається ефективне розсіяння потоку пари і розширення діаграми направленості (рис. 3, б). Численні дослідження, проведені в аналогічних умовах, показують, що зменшення довжини вільного пробігу частинок, яка пропорційна тиску у вакуумній камері, впливає на підвищення ефекту об'ємного напіління значно ефективніше, ніж це мало б бути тільки від зіткнень атомів і молекул між собою і зміни при цьому напрямку їх поширення.

При збільшенні тиску від $1 \cdot 10^{-3}$ мм рт. ст. всього до $1,1 \cdot 10^{-3}$ мм рт. ст. відносна інтенсивність під кутом 45° зростає у 2 рази.

Разом з тим спостерігається підвищення у 2 рази відношення струму іонів, якіпадають під кутом 45° до осі випарника, до швидкості осадження вздовж осі випарника. Це говорить про те, що зменшення довжини вільного пробігу впливає на ефективність об'ємного напіління, перш за все, через підвищення іонізації потоку пари, збільшення рухливості заряджених частинок в електричному полі.

На підтвердження цього висновку говорить те, що розширити діаграму направленості потоку пари можна збільшенням струму розряду. При цьому на рис. 4 видно, як зростає швидкість випарування, яка пропорційна тиску парів у потоці відповідно до теорії Герца – Кнудсена [4], при збільшенні розрядного струму (крива 1). Крива 2, яка відповідає залежності коефіцієнта іонізації потоку α при куті вимірювання 45° від розрядного струму, зростає значно крутіше кривої 1. Розрахунки α були проведені на основі запропонованого в [5] виразу експериментально одержаних величин іонного струму на підкладкотримач I_i і маси напіленої речовини Δm_0 :

$$\alpha = \frac{n_i \cdot v_i}{(n_i \cdot v_i + n_a v_a)} = \frac{I_i \cdot M_a \cdot t}{Z \cdot e \cdot \Delta m_0},$$

де n_i , v_i – концентрація і швидкість іонів потоку; n_a , v_a , M_a – концентрація, швидкість і маса атомів напіленої речовини; t – час напіління; Ze – заряд іона. Покладено $Z = 1$.

На рис. 4 видно, що відносна інтенсивність потоку, вимірюна під кутом 45° (крива 3), зростає так, як крива 2. Це підтверджує те, що діаграма направленості потоку пари ефективно розширяється від зростання кількості зіткнень за одиницю часу іонної складової потоку через взаємодію з електричним полем.

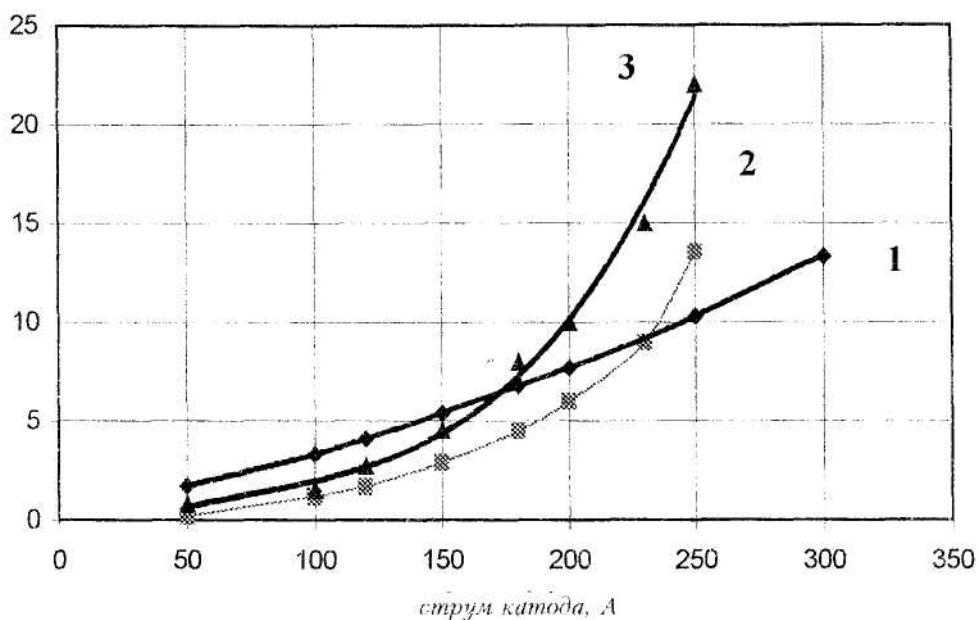


Рис. 4. Залежність від струму катода вакуумно дугового розряду:
 1 - швидкості випаровування V , мг/с; 2 - коефіцієнта іонізації $\alpha^* \cdot 10^2 (\theta = 45^\circ)$,
 3 - відносна інтенсивність потоку (швидкість осадження) $\frac{I_\theta}{I_0} \cdot 10^2 (\theta = 45^\circ)$

В той же час можна сказати, що зіткнення атомів і молекул потоку пари і молекул газу в меншій мірі впливає на об'ємне напіливання. На рис. 5 наведено діаграми направленості потоку пари для термічного випарника хрому. Випаровування проводилось із тигля пітриду бору з площею випаровування 3 см² на підкладку, яка знаходилась від тигля на 15 см. Тигель розігрівався від вольфрамової спіралі, яка була зовні закрита системою теплових екранів. Температура поверхні випаровування підтримувалась 1400 °C, що контролювалось прометричними методами. Тиск азоту у вакуумній камері для рис. 5, а відповідає $3 \cdot 10^{-4}$ мм рт. ст. при граничному залиновому тиску $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст., а для рис. 5, б - $1 \cdot 10^{-3}$ мм рт. ст.

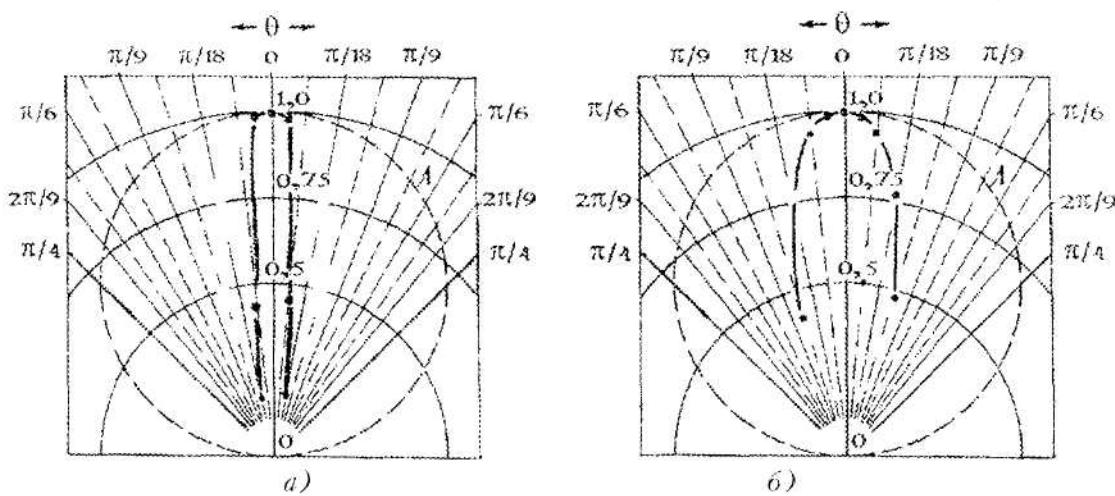


Рис. 5. Діаграма направленості потоку хрому, який випаровується термічно

Дослід показав, що значне збільшення відносної інтенсивності потоку пари спостерігається під кутами від 5° до 15° . При цьому видно кореляцію між збільшенням тиску і, відповідно, збільшенням кількості зіткнень між частинками та збільшенням відносної інтенсивності потоку пари.

Висновки.

Наші дослідження виявили значний вплив на просторовий розподіл інтенсивності потоку пари і бокове запилення від тиску газу, який напускається у вакуумну камеру, і відстані від випарника до підкладки. Залежність пояснюється впливом додаткової іонізації і мас екстремум функції. Найкращим для технологій, які використовують об'ємне нанесення покриттів, є створення для кожного випарника умов, при яких відстань від випарника до підкладки в 2:3 рази перевинує довжину вільного пробігу молекул. За цих умов чисельне значення інтенсивності потоку пари зменшується тільки в 2 рази. За цієї причини можемо говорити про переваги плазмових випарників над термічними. Проте практика осадження та синтезу пілівок у вакуумній камері накладає додаткові вимоги до пілівок, наприклад, однорідність пілівки. Використання вакуумно-дугових випарників для об'ємного нанесення здійснюється простіше, ніж випарників з тиглями. Це пояснюється можливістю розмістити інтегрально-холодний катод у будь-якому положенні у вакуумній камері. Так само можна говорити про випарники сублимуючих матеріалів. Проте використання вакуумно-дугового розряду для випаровування обов'язково призводить до краєльної фази, а значить, і неоднорідності пілівки. Наближення такого випарника до підкладки призводить до збільшення краєльної фази, а віддалення зменшує коефіцієнт використання речовини випарника і ефективність об'ємного нанесення, як наслідок зменшується інтервал оптимального тиску реакційного газу.

У випадку використання джерел плазми з однорідним випаровуванням якісна пілівка може бути отримана на відстанях 5-40 см. Це дає можливість говорити, що оптимальний інтервал тиску газів (реакційних чи інертних), які напускаються у вакуумну камеру, для об'ємного нанесення відповідає $6 \cdot 10^{-4}$ мм рт. ст. - $1 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст. Для вакуумно-дугових джерел можна говорити лише про інтервал $6 \cdot 10^{-4}$ мм рт. ст. ± $4 \cdot 10^{-3}$ мм рт. ст.

Для сублимуючих матеріалів можна зробити однорідне випаровування як для термічних, так і для плазмових випарників. У випадку, якщо технологія дозволяє використання матеріалів, у яких тиск насиченої пари досягає $1 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст. іще у твердому стані, треба використовувати плазмові випаровувачі, наприклад, на основі розряду з термоізольованим анодом. Із плазми парів при напуску газу позитивний потенціал анода ефективно витягує рухливі електрони, які розігрівають робочий матеріал для випаровування.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Внуков Ю.Н., Марков А.А., Лаврова Л.В., Бердышев И.Ю. Нанесение износостойких покрытий на быстрорежущий инструмент. - К., 1992. - 143 с.
2. Габович М.Д., Плещиццев Н.В., Семашко И.И. Пучки ионов и атомов для управляемого термоядерного синтеза и технологических целей. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 248 с.
3. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. - М.: Наука, 1987. - 590 с.
4. Технология тонких пленок. Справочник / Под ред. Л.Майссела, Р.Гленга. - М.: Сов. радио, 1977. - Т. 1. - 664 с.
5. Саєнко В.А. Устройства термоионного осаждения // Приборы и техника эксперимента. - 1985. - № 3. - С. 9-21.

ГРАБАР Іван Григорович – доктор технічних наук, професор, перший проректор, проректор з наукової роботи Житомирського державного технологічного університету, завідувач кафедри автомобілів і механіки технічних систем.

Наукові інтереси:

- міцність конструкцій;
- пелінгійні явища та моделі;
- супергетика;
- нові технології.

РУДНИЦЬКИЙ Валентин Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- нові технології;
- плазма газового розряду.